

0.8 μm SLDモジュール AS8B115G

AS8B115Gは、光コヒーレントトモグラフィ（OCT）をはじめ、各種光学測定機器用の低コヒーレント光源として設計されたスーパーリミネッセントダイオード（SLD）モジュールです。

特長

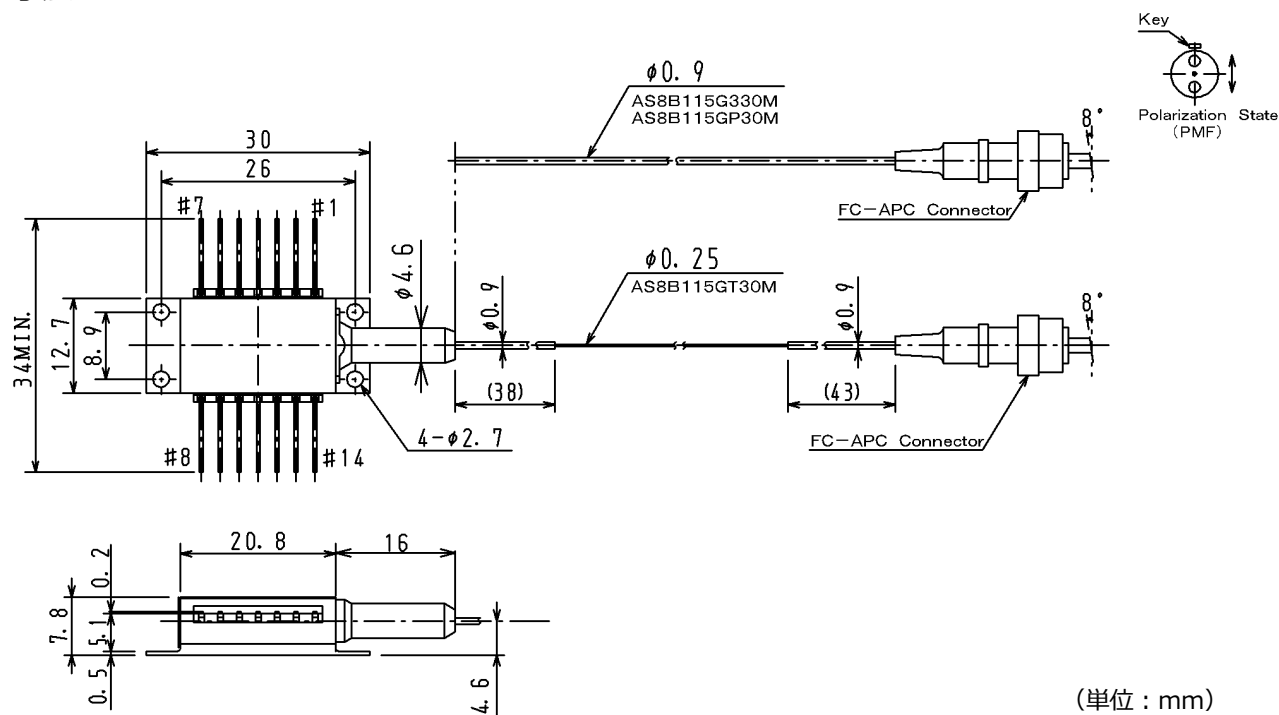
- ・ 光出力 : 5 mW ($I_F \leq 150$ mA)
- ・ スペクトル幅 : 14 nm typ.
- ・ ファイバ :
シングルモードファイバ (SMF)
偏波保存ファイバ (PMF)
- ・ FC-APCコネクタ付き
- ・ 14ピンバタフライパッケージ, モニタPD, クーラ内蔵



用途

- ・ 光干渉断層計（OCT）
- ・ 光ファイバジャイロスコープ（FOG）
- ・ 各種光センシング用光源

外形寸法



(注) LDの偏波方向はPMFのスロー軸に対して平行です。(PMF)

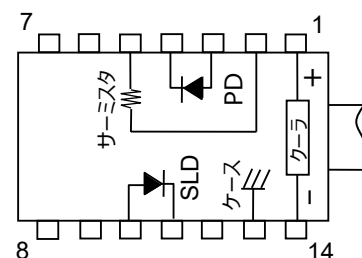
ファイバ仕様

形名	ファイバ	ファイバ長
AS8B115GT30M	SMF $\phi 0.25$ UV コート	0.4m
AS8B115G330M	SMF $\phi 0.9$ ルースチューブ	0.4m
AS8B115GP30M	PMF $\phi 0.9$	1m min.

端子接続

No.	FUNCTION	No.	FUNCTION
1	クーラアノード	8	NC
2	サーミスタ	9	NC
3	PDアノード	10	SLDアノード
4	PDカソード	11	SLDカソード
5	サーミスタ	12	NC
6	NC	13	ケース
7	NC	14	クーラカソード

TOP VIEW



絶対最大定格

項目	記号	定格	単位
光出力	P_f	6.0	mW
SLD順電流	I_F	220	mA
SLD逆電圧	V_R	2.0	V
PD逆電圧	V_{RD}	20	V
動作ケース温度	T_C	-20 to 70	°C
保存温度	T_{stg}	-40 to 85	°C
クーラ電流	I_C	2.0	A

*絶対最大定格を超えると故障の原因になることがあります

電氣的・光学的特性 (T_{SLD} = 25°C, T_C = 25°C)

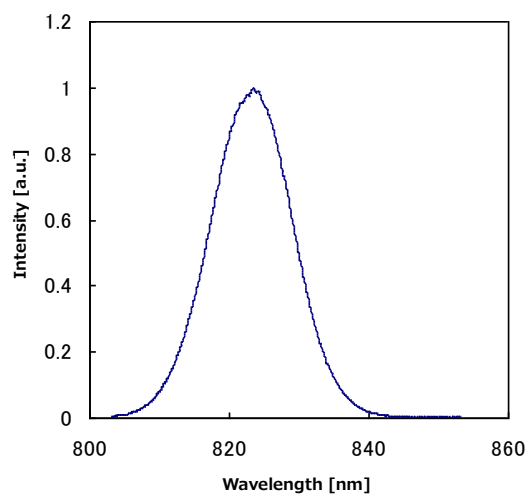
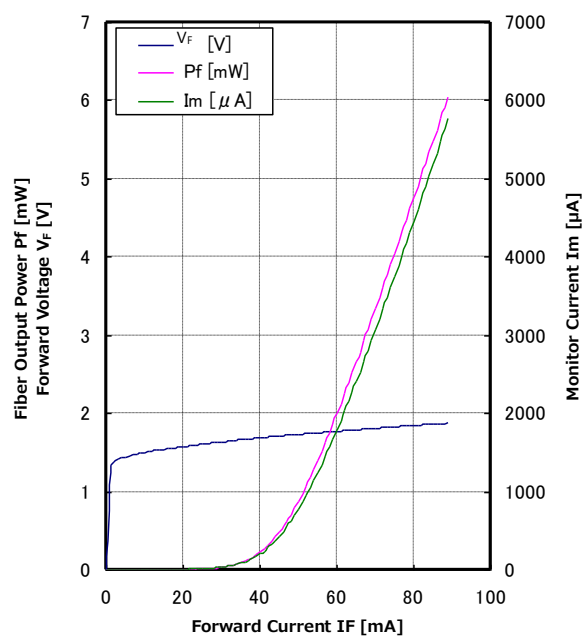
項目	記号	測定条件	Min.	Typ.	Max.	単位
順電圧	V_F	$P_f = 5 \text{ mW}$	–	2.0	2.5	V
順電流 (BOL)	I_F	$P_f = 5 \text{ mW}$	–	–	150	mA
中心波長	λ_C	$P_f = 5 \text{ mW}$	810	830	850	nm
スペクトル幅	$\Delta\lambda$	$P_f = 5 \text{ mW}$, -3 dB	10	14	–	nm
モニタ電流	I_m	$P_f = 5 \text{ mW}$, $V_{RD} = 5 \text{ V}$	0.2	–	–	mA
トラッキングエラー	ΔP_f	$I_m = \text{const.}$, $T_C = -20 \text{ to } 70^\circ\text{C}$	-1.0	–	1.0	dB
クーラ電圧	V_C	$I_F = \text{EOL}^{*1}$, $T_C = 70^\circ\text{C}$	–	–	2.5	V
クーラ電流	I_C	$I_F = \text{EOL}^{*1}$, $T_C = 70^\circ\text{C}$	–	–	1.0	A
サーミスタ抵抗	R_{th}	$T_{LD} = 25^\circ\text{C}$, $B = 3900 \pm 100 \text{ K}$	9.5	10.0	10.5	kΩ

*1 EOL = BOL × 1.2

標準特性例

光出力 (Pf) / 順電圧 (V_F) / モニタ電流 (I_m)

発光スペクトラム



オーダーリングインフォメーション

形名	ファイバ
AS8B115GT30M	SMF ϕ 0.25 UV コート
AS8B115G330M	SMF ϕ 0.9 ルースチューブ
AS8B115GP30M	PMF ϕ 0.9



CAUTION : Handle the fiber of the enclosed device(s) with extreme care ; glass fiber is subject to breakage if mishandled and permanent damage to the device may result. Do not pull the device by the fiber or protective sleeve.
Do not coil the fiber into a loop of than 30 mm in radius.

SEMICONDUCTOR LASER

AVOID EXPOSURE
Invisible laser radiation is emitted from this aperture

DANGER

INVISIBLE LASER RADIATION
AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO
DIRECT OR SCATTERED RADIATION

OUTPUT POWER 500mW
WAVELENGTH 0.80 to 1.80 μm
CLASS IIIb LASER PRODUCT

Caution - use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.
This Product Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11
Manufactured Anritsu Corp. 5-1-1 Onna, Atsugi-shi, Kanagawa, Japan

Anritsu Advancing beyond

アンリツ株式会社

センシング&デバイスカンパニー 営業部
<https://www.anritsu.com/sensing-devices>

〒243-8555 神奈川県厚木市恩名5-1-1
TEL 046-296-6783 FAX 046-225-8390



お問合せURL

<https://www.anritsu.com/ja-jp/sensing-devices/contact-us>



ご使用前に「光デバイス取扱い上の注意点」をお読みください。

<https://www.anritsu.com/ja-jp/sensing-devices/guide/optdevices-handling>



■本製品を国外に持ち出すときは、外国為替および外国貿易法の規定により、日本国政府の輸出許可または役務取引許可が必要になる場合があります。また、米国の輸出管理規則により、日本からの再輸出には米国商務省の許可が必要となる場合がありますので、必ず弊社の営業担当までご連絡ください。

■記載事項はお断りなしに変更することがあります。